

(19)  
(12)

(KR)  
(B1)

(51) 。 Int. Cl.<sup>6</sup>  
H01L 21/3065

(45)  
(11)  
(24)

2005 02 05  
10-0457497  
2004 11 08

(21) 10-1997-0019715  
(22) 1997 05 21

(65)  
(43)

10-1998-0084087  
1998 12 05

(73) 416

(72) 123-23

(74)  
:

(54)

(Particle)

가 , 가 , AI , AI ,  
가 , AI ,  
가 , ,

3

1  
2  
3 2

CVD(Chemical Vapor Deposition)

(Particle)

300 가  
 CVD 가  
 CVD 가  
 (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)  
 (Free radical)  
 1  
 (2) (2) 가 (3)  
 (2) (4)가 (4)가 NH<sub>3</sub>, SiH<sub>4</sub> (2)  
 가 ( ) (10) AI (6)가 AI (6)  
 ) RF 가 가 (8) , , 20 (5) AI (6)  
 (5) (10) AI (6) (2)  
 , AI (6) 가 AI (7) (7)  
 RF (1) 가 (1) 가 (1)  
 가 (9)가 (9) (2) 가 (1) (1)  
 가 (10) 가 (2) (10) 가 (2) 가  
 (8) (11) (2) (2) 가  
 가 CVD (In-Line) (2) 가  
 가 CVD (3) (2) 가  
 CVD (5) (10) 가  
 (5) (10) (2) (1) (10) (10)  
 (5) (10) (5) (10)  
 (Stress) (5) (10) (2) ( )  
 2) , ,  
 , ,  
 , ,  
 가 가 ,  
 AI , AI 가 ,  
 AI ,

SiC 가

2 , 3

(100) (5) (10) (100) (5) (10)

(Reinforcement plate:101)

(1) (2) (3)

(2) 가 (2) (8)가 (8)

(2) Al (6) 가 RF 가 (2) (10)

(5) (100) (5) (10)

(5) (100) (101)

(101) (101a) (100)

(101) (100) (101a)

(102) (101a) (101) (100)

b) (101) (101a) (101b) (101)

(4) (Main body) (101b) (4) (10)

(101) (100) (5)

(100) (100a) (100)

(5)가

가 (1) (10)

(10) (5) 가 (10) (5)

(10) (5) (2) (10) (2)

0) (5) (10) (5) (100) (100) (1)

(10) (5) 가 (100) SiC

(2) 가 (100) (100)

(2) (100)

(2) (5) (10) (100)

(2) (2)

Plasma enhanced CVD) 가 가 , PECVD( 가

(57)

1. 가 ;  
 ;  
 Al ;  
 Al 가 ;  
 ;  
 ;

2. 가 ,



